

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2-06^a

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И ПОДВИЖНОСТИ ОСНОВНЫХ
НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ**

**Методические указания к выполнению
лабораторной работы по курсу “Общая физика” по теме
“Электричество и магнетизм” для студентов всех
специальностей**

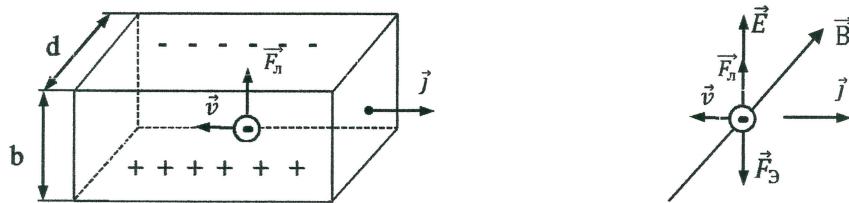
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И ПОДВИЖНОСТИ ОСНОВНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Цель работы: определить концентрацию и подвижность носителей заряда в полупроводниках на основании измерений эффекта Холла. Измерения проводятся при постоянном токе в постоянном магнитном поле на образцах арсенида галлия.

Приборы и принадлежности: образец арсенида галлия, электромагнит, источник постоянного тока, цифровой вольтметр, цифровой миллиамперметр.

КРАТКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Холл обнаружил в 1880 году следующее явление: если металлическую пластинку, вдоль которой течет постоянный электрический ток, поместить в перпендикулярное к ней магнитное поле, то между параллельными току и полю гранями возникает разность потенциалов. Это явление называют эффектом Холла или гальваномагнитным явлением. Холловская разность потенциалов определяется выражением $\Delta\varphi = R_h b j B$ (1), где b – ширина пластинки, R_h – коэффициент пропорциональности, j – плотность тока, B – индукция магнитного поля. Эффект Холла просто объясняется электронной теорией.



Проводник с током I находится в однородном магнитном поле с индукцией \vec{B} . На каждый электрон, имеющий скорость упорядоченного движения \vec{v} действует сила Лоренца $F_L = evB$. Она всегда перпендикулярна к скорости движения заряда \vec{v} и индукции магнитного поля \vec{B} : $\vec{F}_L \perp \vec{v} \perp \vec{B}$. Сила Лоренца не совершает работы над частицей, следовательно, кинетическая энергия не меняется. Сила Лоренца изменяет только направление скорости движения. На верхней поверхности проводника появится избыточное количество электронов, и она зарядится отрицательно. На нижней поверхности недостаток электронов, и она зарядится положительно. Между верхней и нижней поверхностями образуется разность потенциалов. Возникает поперечное электрическое поле перпендикулярно к \vec{v} и на электрон действует сила $F_E = eE$. Когда напряженность этого поля достигает такой величины, что его действие уравновешивает силу Лоренца, установится стационарное распределение зарядов в поперечном направлении. В установленемся состоянии должно соблюдаться равенство $evB = eE$.

Связь между \vec{E} и \vec{B} :

$$E = vB \quad (2)$$

Разность потенциалов, возникающая между гранями равна произведению напряженности поля на расстояние между ними.

$$\Delta\varphi = bE \quad (3)$$

Подставляем (2) в (3) и получаем

$$\Delta\varphi = b\nu B \quad (4)$$

Плотность тока $j = nev$, где e – заряд электрона, n – число электронов в единице объема (концентрация). Выразим среднюю скорость направленного движения электронов v через концентрацию электронов и плотность тока

$$v = \frac{j}{ne} \quad (5)$$

Подставляя (5) в (4), получаем

$$\Delta\varphi = \frac{bBj}{ne} \quad (6)$$

Сравнивая (1) и (6), видим, что постоянная Холла определяется концентрацией электронов и зарядом электрона: $R_H = \frac{1}{ne}$. Исходя из этого, получаем разность потенциалов:

$$\Delta\varphi = R_H b j B \quad (7)$$

Разность потенциала пропорциональна плотности тока и индукции магнитного поля.

Выразим постоянную Холла через силу тока $I = jS$ и напряженность магнитного поля $B = \mu_0 H$.

$$\Delta\varphi = R_H \frac{I\mu_0 H b}{bd} = R_H \frac{I\mu_0 H}{d} \quad (8)$$

Где d -линейный размер полупроводника в направлении вектора \vec{B} .

$$\mu_0 = 12,57 \cdot 10^{-7} \frac{A}{m} \text{ (магнитная постоянная)}$$

Из формулы (8) постоянная Холла

$$R_H = \frac{\Delta\varphi d}{I\mu_0 H}$$

Подвижность носителей тока численно равна средней скорости, приобретаемой носителями при напряженности поля, равной единице.

$$\mu = \frac{v}{E}$$

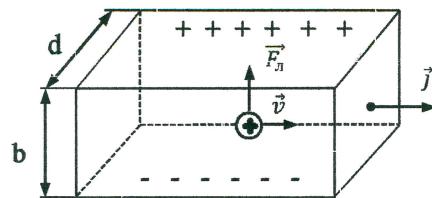
$$[\mu] = m^2/(V \cdot s)$$

Проводимость $\sigma = \frac{j}{E} = \frac{nev}{E} = ne\mu$. Тогда подвижность носителей определим через проводимость и постоянную Холла

$$\mu = \frac{\sigma}{ne} = \sigma R_H \quad (9)$$

Измерив постоянную Холла R_H и проводимость можно определить концентрацию и подвижность носителей заряда в соответствующем образце.

Эффект Холла наблюдается не только в металлах, но и в полупроводниках. В полупроводниках постоянная Холла больше, чем у металлов примерно в 10^5 раз. Например, для алюминия $R_H = 0,30 \cdot 10^{-10} m^3/Kl$, а для окиси цинка $1,6 \cdot 10^{-5} m^3/Kl$. У некоторых полупроводников эффект Холла имеет противоположный знак. При том же направлении тока и индукции магнитного поля, верхняя грань заряжается положительно



Можно предположить, что проводимость в этих веществах осуществляется за счет движения положительных зарядов. Классическая электронная теория объяснить это явление не может.

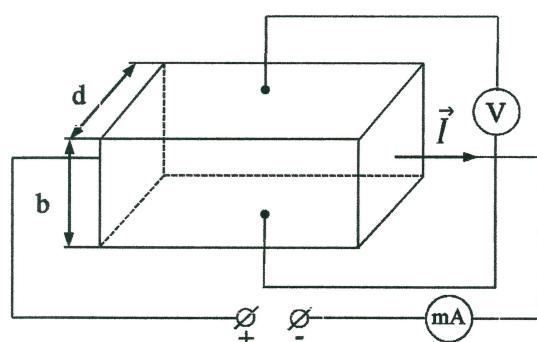
На базе классической электронной теории невозможно объяснить, почему в металлах концентрация электронов проводимости не зависит от температуры, а у полупроводников такая зависимость имеется. Объяснение этих отличий дает квантовая теория проводимости. Измерение постоянной Холла для полупроводника позволяет судить о типе его проводимости: в случае электронной проводимости (n-типа) $R_H < 0$, в случае дырочной проводимости (p-типа) $R_H > 0$.

Если в проводнике наблюдаются оба типа проводимости, то по знаку постоянной Холла можно определить, какой тип проводимости преобладает.

Эффект Холла широко используется для измерительных цепей. Датчики Холла-эффекта сделаны из небольшой полупроводниковой пластины, или из тонкого слоя полупроводника на слюдяной пластинке: два электрода служат для подвода тока, два - для измерения поперечной разности потенциалов.

В работе используется образец арсенида галлия. Арсенид галлия – полупроводниковое соединение, образованное элементами III и IV групп периодической системы. Арсенид галлия имеет определенную концентрацию и подвижность носителей заряда. Кристаллы арсенида галлия применяются для изготовления фотоэлементов, лазеров, генераторов СВЧ-диапазона.

Схема экспериментальной установки:



V – цифровой вольтметр для измерения разности потенциалов.

mA – цифровой миллиамперметр для измерения силы тока, проходящего через прямоугольный образец.

Образец (тонкая пластинка) толщиной $d = 4,5 \cdot 10^{-6}$ м помещается между полюсами электромагнита.

Формула для расчета постоянной Холла с учетом поправок:

$$R_H = \frac{\Delta \varphi / d}{k \mu_0 I_H} \quad (10)$$

I – сила тока, проходящего через образец арсенида галлия,
 μ_0 – магнитная постоянная,
 H - напряженность магнитного поля, создаваемого электромагнитом,
 $\Delta\varphi' = \Delta\varphi - \Delta\varphi_0$ – разность потенциалов, возникающая между гранями за счет действия магнитного поля электромагнита.
 $k=100$ – коэффициент усиления.

Методика и техника эксперимента

- 1) Ознакомиться с приборами лабораторной установки.
- 2) Включить источник питания и установить напряжение на электромагните $U_{\text{эм}} = 0$
- 3) Включить источник для подачи тока на образец Холла. Установить ток ≈ 7 мА.
- 4) Определить разность потенциалов $\Delta\varphi_0$ и записать в таблицу.
- 5) По заданию преподавателя установить $U_{\text{эм}}$ и определить разность потенциалов $\Delta\varphi$.
- 6) Повторить пункты 2,3,4,5, пропуская ток $\approx 8,5$ мА, 10 мА. Для каждого значения тока устанавливать $U_{\text{эм}}$ в пределах от 5 В до 12 В с шагом 2-3 В.

Таблица 1

$U_{\text{эм}}, \text{В}$	$I_1 =$, мА		$I_2 =$, мА		$I_3 =$, мА	
	$\Delta\varphi_{01}$		$\Delta\varphi_{02}$		$\Delta\varphi_{03}$	
	$\Delta\varphi_1$	$\Delta\varphi'_1$	$\Delta\varphi_2$	$\Delta\varphi'_2$	$\Delta\varphi_3$	$\Delta\varphi'_3$
$U_{\text{эм}1} =$						
$U_{\text{эм}2} =$						
$U_{\text{эм}3} =$						

- 7) Рассчитать $\Delta\varphi'_1 = \Delta\varphi_1 - \Delta\varphi_{01}$. Аналогично, рассчитать $\Delta\varphi'_2$ и $\Delta\varphi'_3$. Полученные результаты занести в таблицу.
- 8) Значения напряженности магнитного поля H для заданных напряжений источника питания электромагнита определить по графику зависимости $H = f(U_{\text{эм}})$. Данные занести в таблицу 2

таблица 2

$U_{\text{эм}}, \text{В}$	$H, \text{А/м}$

- 9) По формуле (10) рассчитать значения постоянной Холла для всех серий измерений и определить среднее значение $R_{H\text{cp}} = \frac{\sum_i^n R_{Hi}}{n}$

- 10) Зная постоянную Холла, определить концентрацию носителей заряда $n = \frac{1}{R_{Hcp}e}$, где R_{Hcp} - среднее значение, e – заряд электрона.
- 11) Определить подвижность носителей заряда по формуле $\mu = \sigma R_h$, где $\sigma = 2,35 \cdot 10^4 \Omega^{-1} \cdot m^{-1}$.
- 12) Сравнить полученные значения подвижности носителей заряда с табличными значениями.
Для арсенида галлия табличные значения:
а) подвижность электронов равна $0,92 \text{ м}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$
б) подвижность дырок равна $0,04 \text{ м}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$
- 13) Рассчитать погрешность определения постоянной Холла.
- 14) Сделать вывод.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ

- 1) В чем состоит физический смысл эффекта Холла?
- 2) Почему на боковых гранях проводника с током в поперечном магнитном поле появляются электрические заряды?
- 3) Какова природа электрического поля в образце Холла?
- 4) Запишите условие равновесия для электрической и магнитной составляющих силы Лоренца.
- 5) Эффект Холла характерен только для полупроводников, или он наблюдается также для металлов? Ответ обосновать.
- 6) Получите размерность постоянной Холла, сравните ее с размерностью сопротивления, и сделайте вывод.
- 7) Почему знак постоянной Холла совпадает со знаком носителей заряда?
- 8) Как выбирают знак R_h при наличии нескольких носителей заряда в полупроводниках?
- 9) Изменяется ли кинетическая энергия частицы при ее движении в магнитном поле?
- 10) По какому правилу определяется направление силы Лоренца?
- 11) Как движется заряженная частица в магнитном поле, если направление скорости совпадает с направлением индукции магнитного поля?
- 12) Как связана магнитная индукция с напряженностью магнитного поля?
- 13) Вывести размерности подвижности носителей заряда.
- 14) Является ли зависимость R_h от B линейной? Ответ обосновать.
- 15) Является ли зависимость $\Delta\varphi$ от B линейной? Ответ обосновать.

Методические указания составлены инженером кафедры общей физики ФТИ Петелиной В.М.

Рецензент:

Кедров Марисов Б.А.